

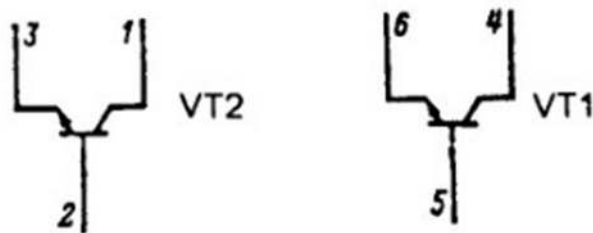
Микросхема К129НТ1

Серия К129

В состав серии К129 входит тип К129НТ1-1 (8 типонаименований).

**К129НТ1А-1, К129НТ1Б-1, К129НТ1В-1,
К129НТ1Г-1, К129НТ1Д-1, К129НТ1Е-1,
К129НТ1Ж-1, К129НТ1И-1**

Микросхемы представляют собой базовую схему дифференциального усилителя (два транзистора n-p-n типа). Содержат 2 интегральных элемента. Бескорпусные ИС с гибкими выводами, масса не более 4 мг.



Электрическая схема К129НТ1-1

Назначение выводов: 1 — коллектор VT2, 2 — база VT2, 3 — эмиттер VT2, 4 — коллектор VT1, 5 — база VT1, 6 — эмиттер VT1

Электрические параметры

Модуль разности прямых напряжений на переходах эмиттер-база при $U_{кз} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА

| | |
|---|---------|
| К129НТ1А-1, К129НТ1Б-1, К129НТ1В-1, К129НТ1Ж-1 | ≤ 3 мВ |
| К129НТ1Г-1, К129НТ1Д-1, К129НТ1Е-1, К129НТ1И-1 | ≤ 15 мВ |

| | |
|---|----------|
| Обратный ток коллектора при $U_{кз} = 15$ В | ≤ 200 нА |
| Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 4$ В | ≤ 500 нА |
| Ток утечки между транзисторами | ≤ 20 нА |
| Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала: | |
| при $I_э = 1$ мА, $U_{кз} = 5$ В | |
| К129НТ1А-1, К129НТ1Г-1 | 20...80 |
| К129НТ1Б-1, К129НТ1Д-1 | 60...180 |
| К129НТ1Ж-1, К129НТ1И-1 | 40.. 160 |
| при $U_{кз} = 5$ В, $I_э = 0,05$ мА для К129НТ1В-1, К129НТ1Е-1 | > 80 |
| Отношение статических коэффициентов передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большого сигнала при $I_э = 1$ мА, $U_{кз} = 5$ В: | |
| К129НТ1А-1, К129НТ1Б-1, К129НТ1Ж-1 | > 0,85 |
| К129НТ1Г-1, К129НТ1Д-1, К129НТ1И-1 | > 0,75 |
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте $f = 100$ МГц | > 2,5 |
| Емкость коллекторного перехода при $U_{кз} = 5$ В, $f = 10$ МГц | ≤ 4 пФ |
| Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 1$ В, $f = 10$ МГц | ≤ 5 пФ |

Предельно допустимые режимы эксплуатации

| | |
|---|----------------|
| Напряжение коллектор-база | ≤ 15 В |
| Напряжение эмиттер-база | ≤ 4 В |
| Напряжение между транзисторами | ≤ 20 В |
| Ток коллектора (постоянный) | ≤ 10 мА |
| Ток коллектора импульсный ($t_{и} = 30$ мкс) | ≤ 40 мА |
| Мощность рассеяния | ≤ 15 мВт |
| Допустимое значение статического потенциала | 100 В |
| Температура окружающей среды | - 60.. + 75 °С |